

2006年6月15日
株式会社日立製作所

日立製作所フェローの伊藤清男が「IEEE Jun-ichi Nishizawa Medal」を日本人で初めて受賞

株式会社日立製作所のフェローである伊藤清男は、このたび IEEE(米国電気電子学会)*1 より、日本人では初めて「IEEE Jun-ichi Nishizawa Medal」*2 を、国立大学法人広島大学のナノデバイス・システム研究センター 角南英夫教授、ならびに国立大学法人東北大学の大学院工学研究科 小柳光正教授と共同で受賞することになりました。本賞は、「IEEE Edison Medal」などと並ぶ IEEE 上位表彰の一つで、現在首都大学東京学長である西澤潤一氏(元東北大学学長)の半導体基礎材料、デバイス、光通信、電力システムなどにおよぶ幅広い業績を称えるために、2002年に創設されたもので、材料とデバイス科学技術へ多大な貢献をした人へ授与されるものです。

伊藤は、これまで、半導体メモリの研究開発に従事し、1994年には米国・カリフォルニア大学バークレー校の客員教授、1995年にはカナダ・ウォータルー大学の客員教授、2000年には米国・スタンフォード大学の顧問教授として、半導体の発展に貢献してきました。

受賞の対象となったのは、「DRAM メモリセルとアーキテクチャの先駆的貢献」で、1970年代から1980年代に、当社の中央研究所で開発した DRAM メモリセル基本技術に関するものです。本内容について、角南氏は「トレンチ・キャパシタセル」、小柳氏は「スタック・キャパシタセル」、伊藤は「折返しデータ線配置セル」の発明と開発を担ってきました。これらの技術は、1980年代初めから多くの DRAM に採用されています。

なお、授賞式は2006年6月24日に米国ミネソタ州の IEEE Honors Ceremony で行われます。

*1 Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (米国電気電子学会)は、全世界150ヶ国以上の電気電子技術者36万5千人以上によって組織されている世界最大の技術専門国際学会です。

*2 「IEEE Jun-ichi Nishizawa Medal」 歴代受賞者

第1回 (2004) Dr. Frederick H. Dill, Hitachi Global Storage Technologies (元 IBM)

第2回 (2005) Dr. Jerry W. Woodall, 米国・Yale University (元 IBM)

伊藤清男フェローコメント

「つらかったが研究してきてよかった」、これが栄えある西澤メダル受賞に際しての実感です。挑戦と失敗を繰り返したこれまでの研究人生43年が報われたからです。振り返ってみますと、世界を相手にした最先端の大型研究テーマ、それを長期にわたって一貫してやり通せたのは、恵まれた研究環境、特に企業の研究所があったること、また、諸先輩や研究仲間あるいは時代にも恵まれました。そのような研究現場でしたから、今回の受賞につながる優れた研究成果と優れた発明・特許を生み出すことができました。そんな幸運がそう実感させるのだと思います。引き続き、技術開発に取り組み、日本と世界の発展に寄与していきたいと思っています。

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
